精选快讯　硬件快讯　2026年11月21日 11:51

韩媒称中国因缺EUV光刻机致HBM良率仅20%-30%，远低于SK海力士70%

要点

- 韩国方面近日表示，由于中国企业无法购买EUV光刻机，导致其高带宽内存（HBM）良率极低，因此对中国在该领域的进展不足为惧。
- 据称，制造同等容量的HBM内存，其产能需求是DDR内存的2倍或以上。
- HBM制造除标准DRAM技术外，还需硅通孔、堆叠、键合及热控制等先进工艺，且高度依赖EUV光刻机。

韩国方面近日表示，由于中国企业无法购买EUV光刻机，导致其高带宽内存（HBM）良率极低，因此对中国在该领域的进展不足为惧。HBM是基于3D堆叠工艺的高性能DRAM，带宽远超传统DDR和GDDR内存，已成为英伟达、AMD及Intel等公司AI芯片的必备组件，这些芯片通常配置96GB至192GB等高容量HBM。

据称，制造同等容量的HBM内存，其产能需求是DDR内存的2倍或以上。目前，三星、SK海力士和美光垄断了全球HBM市场，国产厂商份额几乎可以忽略。这三家国际巨头已量产第六代HBM4，并可能在明年量产HBM4E。相比之下，国内HBM起步较晚，目前仍处于建立HBM3E稳定量产体系的阶段，技术代际落后于三星等厂商约1至2代。

HBM制造除标准DRAM技术外，还需硅通孔、堆叠、键合及热控制等先进工艺，且高度依赖EUV光刻机。三星和SK海力士使用EUV制造DRAM核心裸片，美光虽以DUV为主但也使用EUV，而逻辑基片制造更需要EUV光刻机。在韩国方面的说法中，缺乏EUV光刻机使得中国企业的HBM良率仅为20%至30%，远低于SK海力士约70%的良率水平。

报道来源：sohu

来源网站：https://www.inews.today/